



## Présentation

**Code interne :** EEL9-MICR2

## Description

Cette formation d'une semaine sur le site de l'AIME donne une approche complète, théorique et pratique, sur les opérations fondamentales de fabrication des circuits intégrés silicium en technologie NMOS, depuis la réception du substrat de silicium jusqu' à la mise en boîtier du composant final et sa caractérisation électrique. Parallèlement, il est procédé à la caractérisation physique des différentes étapes de fabrication.

Le stage se déroule en salle blanche à l'AIME de Toulouse (Atelier Interuniversitaire de Micro-nano-Electronique), pôle CNFM de Toulouse) et fait appel à des moyens matériels lourds.

## Heures d'enseignement

TI	Travaux Individuels	12h
TD	Travaux Dirigés	30h

## Syllabus

- Oxydation du Wafer
- Gravure et diffusion des zones actives
- Dépôt et gravure du polysilicium de grille
- Ouverture des contacts
- Métallisation
- Test sous pointes
- Mise en boîtier
- Caractérisation électrique

## Modalités de contrôle des connaissances

## Évaluation initiale / Session principale

Type d'évaluation	Nature de l'évaluation	Durée (en minutes)	Nombre d'épreuves	Coefficient de l'évaluation	Note éliminatoire de l'évaluation	Remarques
Contrôle Continu Intégral	Contrôle Continu			2		

## Infos pratiques

### Contacts

Éric Kerherve

✉ [Eric.Kerherve@bordeaux-inp.fr](mailto:Eric.Kerherve@bordeaux-inp.fr)

Yann Deval

✉ [Yann.Deval@bordeaux-inp.fr](mailto:Yann.Deval@bordeaux-inp.fr)